



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H8550

对应国外型号
SS8550

主要用途

作便携式收音机 B 类推挽输出 2W 放大器。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	1W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-40V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-25V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-6V
I_C ——集电极电流.....	-1.5A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{CB}=-35V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{EB}=-6V, I_C=0$
H_{FE}	直流电流增益	85 40		500		$V_{CE}=-1V, I_C=-100mA$ $V_{CE}=-1V, I_C=-800mA$
$V_{BE(ON)}$	基极—发射极导通电压			-1.0	V	$V_{CE}=-1V, I_C=-10mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	$I_C=-800mA, I_B=-80mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	$I_C=-800mA, I_B=-80mA$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	$I_C=-100\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	25			V	$I_C=-2mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=-100\mu A, I_C=0$
f_T	特征频率	100			MHz	$V_{CE}=-10V, I_C=-50mA$

分档及其标志

B	C	D	E
85—160	120—200	160—300	270—500